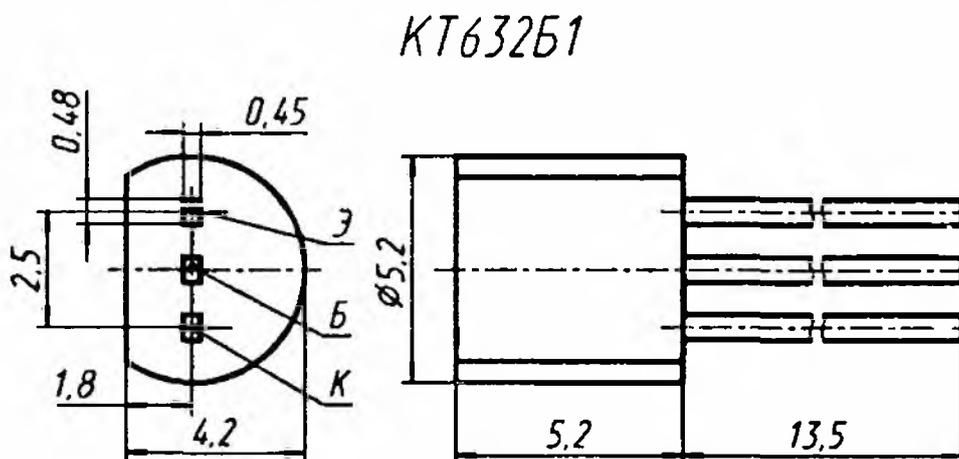
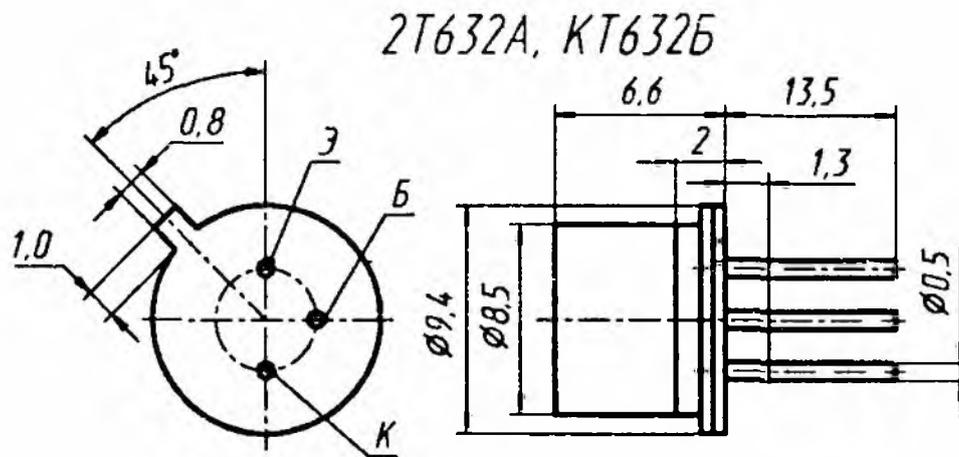


## 2Т632А, КТ632Б, КТ632Б1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* усилительные. Предназначены для применения в линейных широкополосных усилителях. Транзистор 2Т632А, КТ632Б выпускаются в металлическом корпусе с гибкими выводами и стеклянными изоляторами. Тип прибора указывается на корпусе. Транзистор КТ632Б1 выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора в металлическом корпусе не более 1,5 г, в пластмассовом — не более 0,3 г.



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока  
в схеме ОЭ при  $U_{КБ} = 10$  В,  $I_3 = 1$  мА:

$T_K = +25$ °С.....	50...450*
$T = T_{МАКС}$ , не менее.....	50
$T = T_{МИН}$ , не менее.....	15

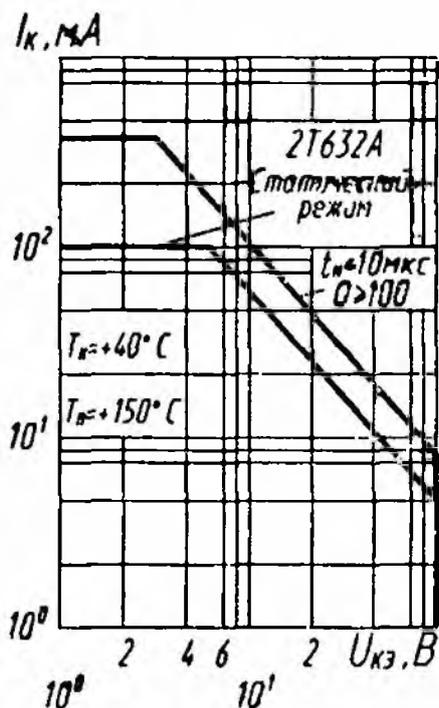
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 20$ В, $I_3 = 20$ мА, не менее .....	200 МГц
Граничное напряжение при $I_3 = 10$ мА, не менее .....	120 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_K = 20$ мА, $I_B = 2$ мА, не более:	
КТ632Б, КТ632Б1 .....	0,8 В
2Т632А .....	0,5 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_K = 20$ мА, $I_B = 2$ мА, не более .....	1 В
Время рассасывания при $I_K = 20$ мА, $I_{Б1} = I_{Б2} = 2$ мА .....	0,75*...1,5*... 2 мкс
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{КБ} = 20$ В, $I_3 = 20$ мА, $f = 30$ МГц .....	20*...50*... 100 пс
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 20$ В, не более .....	8 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{БЭ} = 0$ , не более .....	50 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 120$ В, не более:	
$T = +25$ °С и $T_{МИН}$ .....	1 мкА
$T = T_{МАКС}$ .....	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5$ В, не более .....	100 мкА
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{КЭ} = 120$ В, $R_{БЭ} = 1$ кОм .....	10 мкА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база .....	120 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} = 1$ кОм .....	120 В
Постоянное напряжение эмиттер—база .....	5 В
Постоянный ток коллектора .....	0,1 А
Импульсный ток коллектора при $t_{И} = 10$ мкс, $Q = 10$ .....	0,35 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
$T = T_{МИН} \dots +40$ °С:	

2Т632А, КТ632Б .....	0,5 Вт
КТ632Б1 .....	0,35 Вт
$T = T_{\text{МАКС}}$ для 2Т632А, КТ632Б .....	0,1 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $t_{\text{и}} = 20$ мкс, $Q = 10$ для 2Т632А, КТ632Б:	
$T = T_{\text{МИН}} \dots +40$ °С .....	1 Вт
$T = T_{\text{МАКС}}$ .....	0,2 Вт
Температура р-п перехода .....	+150 °С
Температура окружающей среды:	
КТ632Б, КТ632Б1 .....	-45...+85 °С
2Т632А .....	-60...+125 °С

Изгиб выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса транзистора с радиусом изгиба не менее 1,5 мм. Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре пайки не более +280 °С в течение не более 3 с.



Области максимальных режимов